くし形電極セルにおける分子配向場の数値シミュレーション

システム工学群

(1)

流体工学研究室 1200033 大熊 風葵

1. 緒言

液晶研究は LCD を目的とされたものが多くを占め、その 内容は液晶の光学的な性質を利用したものとなっている.し かし、近年パネル製造の技術の成熟化や有機 EL の登場など 液晶はその利用の多様化が求められる段階に達しており,液 晶の電場応答性や背流効果などの流体力学的な性質を活用 し、無定形アクチュエータやマニピュレータとして機械分野 での利用について研究がなされている.

液晶は実際に液晶分子がどの向きを向いているかを計算 によって求めることができる.またその配向には液晶分子に かかる電場の大きさや向きが影響を受けているため正確な 電場の計算が不可欠となる.本研究は横電界に着目し,片側 の電極のみで横電場をかけることのできるくし形電極セル を用いる.セル内で,液晶の分子配向がどのような分布を示 すかについて数値シミュレーションによって明らかにする.

2. 計算条件

今回実験で用いる液晶セルは図 1 のような構成になって いるに示す.

厚さ 16[µm], 幅 1300[µm], ベタ基盤厚さ 700[µm]となっている.

ベタ基盤,くし形電極の表面は垂直に配向処理がなされている.

このセルの液晶部に光を透過したときの偏光を計算する ために電極に電荷をかけた場合の液晶分子の配向について 求める必要がある.

くし形電極は正極と負極が櫛のように交互にかみ合わせ られた電極である.この電極を用いれば平板の電極のように 挟み込むことなく片面に設置された電極に電荷をかけるこ とで簡単に横電場を生み出すことが可能である.(図1を参 照)

なお,今回使用したくし形電極は幅 50[µm],間隔 50[µm] となっている.その他のくし形電極の寸法を表1に示す.

液晶セル上の測定対象は図 1 に示す通りくし型電極上に 収まり、くし形電極が作る電場についてのシミュレーション は正極と負極が交互に一定間隔で現れる箇所を求めればよ いので 2 次元空間での解析で全地点での電場を求めること ができる.解析範囲は図 2 のように正極と負極が 1 つずつ現 れる箇所について解析ができればこれについての結果をパ ターン化することでくし形電極における解析範囲をすべて 網羅することができる.

この電極における電場の分布について事前に計算をする. 電場の強度 E と電束密度 D は誘電率 ϵ を用いて

$$D = \epsilon E$$
 (1) の関係がある.

ここでマクスウェルの定理より

 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$ ここで静電ポテンシャル $\rho \geq$ 電場強度 E は $\nabla \phi = E$ (2)
(3)

であることより $\nabla \cdot \nabla m = \frac{\rho}{2}$

$$\sqrt{\psi - \frac{1}{\epsilon}}$$
 (4)
二次元空間における静電エネルギーを

$$\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_x \\ \varphi_y \end{bmatrix} \tag{5}$$

とすると(5)式は

$$\frac{\partial^2 \varphi_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_y}{\partial y^2} = \frac{\rho}{\epsilon}$$
(6)

と置ける.ここで真電荷が存在しない(
$$\rho = 0$$
)と仮定すると
$$\frac{\partial^2 \varphi_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_y}{\partial y^2} = 0$$
(7)

となる.

静電ポテンシャルφは透過光の計測実験で扱った数値は1 ~10[V]であるので中間にあたる電圧5[V]を用いて

$$\begin{cases} 25[\mu m] \leq x \leq 75[\mu m] \land y = 0 \Rightarrow \varphi_{(x,y)} = 0\\ (125[\mu m] \leq x \leq 175[\mu m] \land y = 0 \Rightarrow \varphi_{(x,y)} = 5 \end{cases}$$
(8)
とおく.
また,差分近似で用いる格子幅は
($\Delta x = 0.5[\mu m]$)

$$= 0.5[\mu m]$$
(9)
= 0.5[\mu m]

とする.(4)式より求まった静電ポテンシャルφを微分するこ とで座標ごとの電場を求める.

 Δy

誘電率電場とプレチルト角の関係は

$$\sin 2\theta \left\{ \{E_x^2 + E_y^2\}\Delta\varepsilon + (K_1 - K_3) \left(\left\{\frac{\partial\theta}{\partial y}\right\}^2 - \left\{\frac{\partial\theta}{\partial x}\right\}^2 + 2\frac{\partial^2\theta}{\partial x\partial y}\right) \right\} + \cos 2\theta \left\{ -2E_x E_y \Delta\varepsilon - (K_1 - K_3) \left(\frac{\partial^2\theta}{\partial y^2} - 2\frac{\partial^2\theta}{\partial x\partial y} - \frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}\right) \right\}$$
(10)
$$- (K_1 - K_3) \left(\frac{\partial^2\theta}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}\right) = 0$$

となっている. またくし形電極. ベタ基盤はともに垂直配向処理がなされている. よって電極, ベタ基盤に面した境界において

$$\theta = 90[^{\circ}] = \frac{\pi}{2}[rad] \tag{11}$$

と置くことができる.

また、5CBの液晶を想定し、弾性定数 K_1 、 K_3 を $K_1 = 6.37 \times 10^{-12}$ (12)

$$K_3 = 8.6 \times 10^{-12} \tag{13}$$

液晶の比誘電率Δεを

$$\Delta \varepsilon = 4.35 \times 10^{-12}$$

(14)



Figure 2 measurement of liquid crystal cell on interdigitated array electrode.



3. 計算結果

くし形電極の電場分布を図3に示す.

正極上,負極上の電場はそれぞれその間に分布する横電場 と比較すると小さな上向き,下向きの電場となっており電極 間の横電場の電場強度はくし形電極側からベタ基盤側まで ほぼ一定で分布している.電場の向きに沿って回転する液晶 分子の特性より約 50 µm間隔で液晶分子は.が生まれている ということが分かる.

また,図5に印加電圧5V,図6は印加電圧10Vの場合の分 子配向の結果を示す.

印加電圧が大きいほど電場に影響され横向きの分子が増 えていることが分かる.電極間の液晶分子の傾きは各電圧に おいて電極上部では初期状態の垂直配向から変化していな い.これは電場が垂直方向に働いている点と電極間の横電場 よりもかなり弱い電場であることに起因する.

電極間において電極ごとに傾きがほとんど変化していな い箇所が存在しており、その位置の x 座標は印加電圧が増す ごとに負電極へとずれていっており、10V ではそのわずかな 傾きも下部側では右に上部側では左に黒線が傾いているこ とが確認できる.





Figure 6 Orientation fieldon interdigitated array electrode.10V.



Figure 6 Orientation fieldon interdigitated array electrode.10V (horizontal alignment)

4. 結言

クシ形電極における電場は、電極中央において垂直な方向に 働いていることが、また正電極負電極の中間点においては水 平方向に電場が働いているという結果が得られた.これは電 気力線の形状に基づく形となっており、想定していた電場分 布と近しいものとなった.

液晶はおよそ電場の分布に基づいて分子配向は変化し、印加 電圧の増加に伴って分子配向に与える影響が大きくなり、よ り電場の分布に近い形へと変化していくことがわかった. しかし、分子配向はこの電場の分布に沿わない箇所も存在し

ており、これは差分法による角度の微分結果が本来の形とは 違う形になってしまう箇所が存在することに起因しており、 新たな離散化方法の策定をする必要がある.

文献

- (1) 横山 浩,近藤 克己,岩壁 靖,横倉 久男, "アンカリング 強度の高精度測定の可能性と問題点",液晶討論会講 演予稿集,第17回 液晶討論会,1991/09/23-1991/09/25.
- 山口留美子,"液晶科学実験講座第18回:表計算ソフトを用いた液晶セルの光学シミュレーション(その1)",液晶:日本液晶学会誌:Ekisho 10(2), 2006/04/25
- (2) 木村宗弘, "液晶科学実験講座 第 15 回 : 界面アンカ リングエネルギー係数測定法(その 1)",液晶:日本液 晶学会誌:Ekisho.9(3), 2005/07/25.
- (3) 金原築, 梶谷剛, 濱島高太郎, 塚田啓二, 杉本秀彦, "専 門基礎ライブラリー電磁気学", 実教出版株式会社, 2018/4/1